

	<h2 style="color: red;">SQ1912AEEH-T1_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQ1912AEEH-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V POWERPAK SC70-6
	Datenblätter:  SQ1912AEEH-T1_GE3.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SQ1912AEEH-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V POWERPAK SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 1.2A, 4.5V
Leistung - max	1.5W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Andere Namen	SQ1912AEEH-T1_GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	27pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.25nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 800mA (Tc) 1.5W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	800mA (Tc)

SQ1912AEEH-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ1912AEEH-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ1912AEEH-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ1912AEEH-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQ1852PV12NF Laird Technologies IAS ANT CEILING/SMT DIPOLE N FEMALE</p>	 <p>SQ1853P12NF Laird Technologies IAS ANT 1850-1990MHZ 3.5DBI N FEMALE</p>	 <p>SQ1912EEH-T1-GE3 VISHAY SQ1912EEH-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ1922EEH-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V SC70-6</p>
 <p>SQ1853PNF Laird Technologies IAS ANT 1850-1990MHZ 3.5DBI N FEMALE</p>	 <p>SQ1912EH-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 20V 800MA SC70-6</p>	 <p>SQ1902AEL-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V POWERPAK SC70-6</p>	 <p>SQ1912EH-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 20V SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ1912AEEH-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQ1912AEEH-T1_GE3 Datenblatt	SQ1912AEEH-T1_GE3-Datenblätter	SQ1912AEEH-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQ1912AEEH-T1_GE3
SQ1912AEEH-T1_GE3 Electronic	SQ1912AEEH-T1_GE3-Komponenten	SQ1912AEEH-T1_GE3-Verteiler	SQ1912AEEH-T1_GE3-Bild	SQ1912AEEH-T1_GE3-Teil
SQ1912AEEH-T1_GE3 Preis	SQ1912AEEH-T1_GE3 Hersteller	SQ1912AEEH-T1_GE3 Bild	SQ1912AEEH-T1_GE3 Aktie	SQ1912AEEH-T1_GE3 Inventar
SQ1912AEEH-T1_GE3 Neu	SQ1912AEEH-T1_GE3 Original	SQ1912AEEH-T1_GE3 garantiert	SQ1912AEEH-T1_GE3 RFQ	SQ1912AEEH-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited